**3P119** 

モノメチルアデニンの励起状態に関する理論的研究

(お茶大院人間文化創成科学) 栢沼愛,鷹野景子

【序】DNA 塩基のアデニンは、紫外光の照射により電子励起状態に遷移しても非放射過程に より速やかに電子基底状態に戻る。そのため、光化学反応によるダメージを受けにくく、光に 対して安定である。同様の性質はアデニンの N9 位に結合した水素原子をメチル基で置換した モノメチルアデニンでもみられる。メチル基の結合位置によりモノメチルアデニンには4種の 異性体が存在する(図1)。水溶液中において、電子励起状態に留まる時間が9MA、3MA、1MA では約200 fs であるのに対し、7MA のみが長く4 ps である、という報告がある<sup>1)</sup>。このこと から、N7 位の非共有電子対が第一励起状態の寿命に関与することが推測されている。一方、 気相中において、7MA と 9MA が励起状態に留まる時間はほぼ等しいという報告がある<sup>2,3)</sup>。 本研究では、構造のわずかな違いや溶媒の存在が、電子励起状態から基底状態に戻る反応経路 におよぼす影響について、ab initio 分子軌道法を用いて考察、議論する。



図1 メチル基の結合位置が異なる4種のモノメチルアデニン

【方法】9MA および 7MA を対象とした。まず、孤立分子に対し、5 状態を考慮した状態平均 多配置 SCF (SA-CASSCF) 法を用いて、電子基底状態および励起状態の安定構造や 2 つの 電子状態が交差する構造 (conical intersection)を探索することにより、分子が電子基底状態 から電子励起状態に遷移した後、基底状態に戻るまでの反応経路を調べた。基底関数は 6-31G(d,p)を用い、CASSCF 計算の active space には (HOMO-2) ~ (LUMO+2) の6 電子 6 軌 道 ( 軌道 5 つ、 軌道 1 つ)を採用した。計算プログラムは MOLPRO を用いた。反応経路 において重要な構造が、溶媒によりどのような影響を受けるかを調べるため、誘電体モデル (PCM)および周囲に複数の水分子を配置した supermolecule 法を用いて、エネルギーー点計 算を行った。supermolecule における水分子の配置は、MD 計算 (MM+力場)により決定し、 電子状態計算を行った。これらの計算により、どの分子軌道や電子状態が影響を強く受けるの か、影響の受け方の異性体間での違いについて考察する。

【結果と考察】基底状態で CASSCF 法により最適化した構造における各状態のエネルギーを 表1に示した。遷移モーメントは 9MA では S₄ が最も大きかった。7MA では S₂ が最も大きく、 次いで S₄ が大きかった。このことから、紫外光を照射されると、主にこれらの電子励起状態に 遷移が起こると考えられる。基底状態の最適化構造(S₀(min.))は、9MA、7MA ともに平面で ある(図2)。第一励起状態 の最適化構造(S<sub>1</sub>(min.)) は、9MA では C2 が環平面 から少しずれており、7MA ではアミノ基の水素が環に 対し垂直方向を向いている (図3)。また、基底状態と 第一励起状態の conical intersection (CI01)は、 9MA では C2 が環平面から 大きくずれており、7MA で

表1 CASSCF最適化構造における5つの電子状態の
相対的なエネルギー(eV)

		9MA		7MA	
		CASSCF	CASPT2	CASSCF	CASPT2
<b>S</b> <sub>0</sub>		0	0	0	0
<b>S</b> 1 (n	*)	6.30	5.83	6.03	5.55
S2 (	*)	6.40	5.53	6.30	5.36
S3 (n	*)	6.82	6.44	6.65	6.05
S4 (	*)	7.16	6.08	7.79	6.48

は環が折れ曲がり六員環と五員環が接近している(図 4)。CASSCF 計算の結果、S1(min.)は CI01 よりもわずかにエネルギーが低く(9MA:0.4 eV、7MA:0.2 eV)、両方とも容易に S1(min.) から CI01 へ至ることができると考えられる。より高い励起状態間の conical intersection( CI12、 CI23、CI34)においても、六員環部分に構造の変化がみられる。特に、9MA では C6-N1 結合 と C2-N3 結合が、7MA では C4-C5 結合と C2-N3 結合が伸びている。これらの結果は、先行 する理論的研究による、「アデニン(9H-アデニン)において六員環のゆがみが反応経路に関与 している」という考察と一致している<sup>4</sup>。溶媒を考慮した結果に関しては、当日報告する。



図 2 SU(IIIII.)の 備迫 因 S SI(IIIII.)の 備迫 因

1) B. Cohen, P. M. Hare, B. Kohler, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 13594.

2) H. Kang, K. T. Lee, B. Jung, Y. J. Ko, S. K. Kim, J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 12958

3) H. Kang, B. Jung, S. K. Kim, J. Chem. Phys. 118 (2003) 6717.

4) S Perun, A. L. Sobolewski, W. Domcke Chem. Phys. 313 (2005) 107